## A Section of the sect

## 第七节 原子的量子理论 激光

1. 根据波尔氢原子理论, 氢原子在n=5的轨道上的动量矩与第一激发态的轨道 动量矩之比为:

解析:根据氢原子波尔理论知:轨道矩为: $L=mvr=n\frac{h}{2\pi}$ ,n=1,2,3,...则n=5和n=2的动量矩之比为:5/2

故选A

2. 根据量子力学原理, 氢原子中电子绕核运动动量矩的最小值为:

解析: 氢原子的轨道矩为:  $L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}$ , l = 0,1,...,n-1 n = 1,2,3...

因为l最小可为0,因此L最小值为0,故选D

3. 可以描述原子中电子状态的是:主量子数n=3都满足,角动量量子数只能取: l=0,1,2,则(2)错;再由磁量子数 $m_l=0,\pm 1,..\pm l$ ;自旋磁量子数为:  $m_s=\pm 1/2$  因此可以用1,3,4来描述,故选C

解析: A中当l=0时, $m_l$ 只能取0,因此A错;B中当n=1时,l最大只能取n-1,因此B错误;C中当l=1时, $m_l$ 只能取:0, $\pm 1$ ,因此C错;D中主量子数n=3时,l可以取0,1,2,当l=2时, $m_l$ 可以取0,  $\pm 1$ , $\pm 2$ ,最后 $m_s$ 可以取  $\pm 1/2$ ,故选D

5. 在原子的K壳层中,电子可能具有的四个量子数 $(n, l, m_l, m_s)$ 是:

解析:原子的核外结构,半径最小的壳层叫K层:n=1,最多容纳2个电子;

因此,轨道量子数l只能取l=n-1=0;对应磁量子数为: $m_l=0$ ;最后 $m_s$ 可以取 $\pm 1/2$ ,因此,2和4正确。故选B

6. 在原子的L壳层中,电子可能具有的四个量子数是 $(n, l, m_l, m_s)$ :

解析:原子的核外结构,半径最小的壳层叫K层,其次为L层,n=2;

因此,轨道量子数l可取0和1;对应磁量子数为: $m_l=\pm l$ ;因此(1)错;

最后 $m_s$ 可以取 $\pm 1/2$ ,因此,2、3、4正确。故选C

- A STATE OF S
  - 7. 世界上第一台激光器是: 1960年7月8日, 美国科学家梅曼发明了红宝石激光器, 从此人们便可获得性质和电磁波相似而频率稳定的光源。 故选D
- 8. 在激光器中利用光学谐振腔可以同时提高激光束的方向性和单色性。故选C
- 9. 按照原子的量子理论,原子可以通过自发辐射和受激辐射的方式发光,它们所产生的光的特点是:

解析:原子自发辐射时,从高能级向低能级跃迁是随机的,两原子自发辐射的光的频率、相位和振动方向都是随机的,因此不是相干光;原子受激辐射出的光子,与入射光子具有完全相同的特性,即频率、相位和偏振方向都相同,因此原子受激辐射发出的光与入射光是相干的。故选B

10. 激光全息照相技术主要是利用激光的相干性好,利用不同点之间的光程差对应的相位差不同,得到光的干涉情况,从而记录物体的立体信息。故选C

- NATIONAL WATER
- 11. N型半导体中杂质原子所形成的施主能级,在能带结构中处于。

解析: N型半导体也称为电子型半导体, 其杂质元素比本征元素多一个电子, 因此在晶体能带结构中, 会出现一个施主能级, 该施主能级将会位于价带的上方导带的下方(即禁带中), 由于该施主能级上的电子非常容易被激发, 跃迁到导带参与导电, 因此该施主能级会非常靠近导带底, 故选D

- 12. 若(1)是指锗用镝(5价元素)参杂; (2)指硅用铝(3价元素)参杂。下列说法正确的是:
- 解析:因为锗是4价,用5价的镝参杂,会多出一个电子参与导电,属于N型半导体;而硅是4价,用3价的铝参杂,则形成一个空穴参与导电,属于P型半导体,故选B
- 13. 根据量子力学原理,当氢原子中电子的动量矩 $L=6^{1/2}\hbar$ 时,L在外磁场方向上的投影 $L_z$ 可取的值分别为:
- 解析:因为动量矩为: $L=6^{1/2}\hbar=[l(l+1)]^{1/2}\hbar$ ;则取l=2;则磁量子数可取:0,  $\pm 1$ ,  $\pm 2$ 。因此 $L_z$ 的值分别为:0,  $\pm \hbar$ ,  $\pm 2\hbar$ 。



- 14. 与绝缘体相比较纯净半导体能带的禁带是较窄的,在常温下有少量电子由满带激发到导带中,从而形成由电子和空穴共同参与导电的本征导电性。
- 15. 思考题: 从能带观点来看, 导体、半导体、和绝缘体有什么区别?

解析:导体:不存在明显的带隙,导体的价带要么与导带重合,要么是由未被电子填满的非满带价电子能级分裂形成的价带,导体中的外层电子可以直接参与导电,因此导体的电导率很高;绝缘体:价带是满占据的,价带与导带之间存在很大的带隙,价带中的电子很难跃迁到导带,电导率很低,在常温和普通电场作用下基本不导电;半导体:绝对零度下价带也是满占据的,但是价带与导带之间的带隙较小,在一定外界刺激下可以产生电子空穴对参与导电,因此其电导率介于导体与绝缘体之间。